

# RT3DSSM

一般スイッチング用  
シリコンエピタキシャル形(シリーズタイプ)

## 概要

RT3DSSM は、超小形外形の樹脂封止形シリコンエピタキシャル形複合ダイオードで、シリーズタイプ MC2850 を 2 素子内蔵しております。

端子間容量が小さくクアドラプル(4個入り)で超小形のため保護回路、バイアス回路等として幅広くご使用いただけます。

## 特長

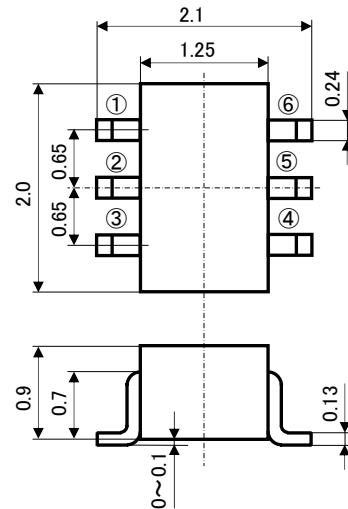
- 端子間容量が小さい
- 超小形パッケージに 4 個のダイオードを内蔵しセットの小形化、高密度実装が可能

## 用途

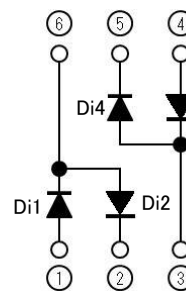
オーディオ機器、VTR 等の一般スイッチング

## 外形図

単位:mm



## 回路図



## 電極接続

- ①:アノード 1
- ②:カソード 2
- ③:カソード 3+アノード 4
- ④:アノード 3
- ⑤:カソード 4
- ⑥:カソード 1+アノード 2

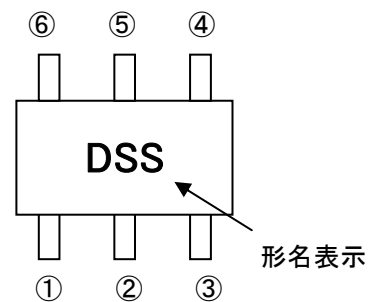
JEITA: SC-88

JEDEC: -

## 最大定格 (Ta=25°C) (Di1・Di2、Di3・Di4 共通)

項目	記号	定格値	単位
せん頭逆電圧	$V_{RM}$	35	V
直流逆電圧	$V_R$	30	V
サージ電流 (1 $\mu$ s)	$I_{FSM}$	4	A
せん頭順電流	$I_{FM}$	300	mA
平均整流電流	$I_O$	100	mA
全損失	$P_T$	200	mW
接合部温度	$T_j$	+150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	°C

## マーキング図



## 電気的特性 (Ta=25°C) (Di1・Di2、Di3・Di4 共通)

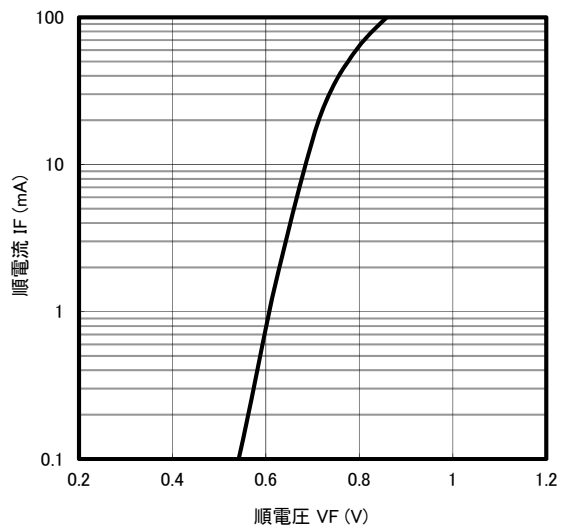
項目	記号	測定条件	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
順電圧	$V_{F1}$	$I_F=10mA$	-	0.75	1.0	V	
	$V_{F2}$	$I_F=50mA$	-	0.85	1.2		
	$V_{F3}$	$I_F=100mA$	-	0.90	1.4		
逆電流	$I_R$	$V_R=30V$	-	-	0.1	$\mu$ A	
端子間容量	$C_t$	$V_R=0V, f=1MHz$	Di1,Di3	-	6	-	pF
			Di2,Di4	-	10	-	

# RT3DSSM

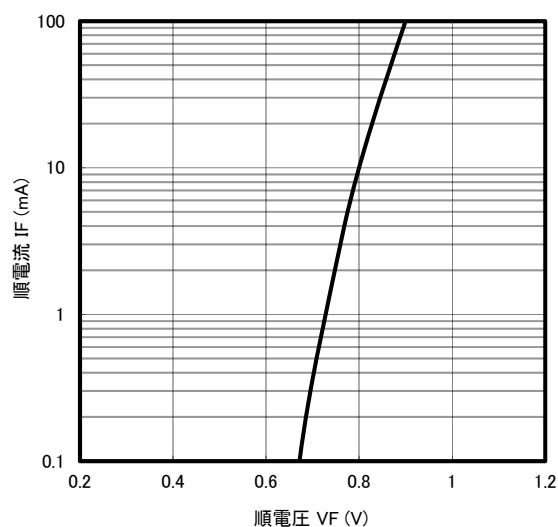
一般スイッチング用  
シリコンエピタキシャル形(シリーズタイプ)

## 標準特性

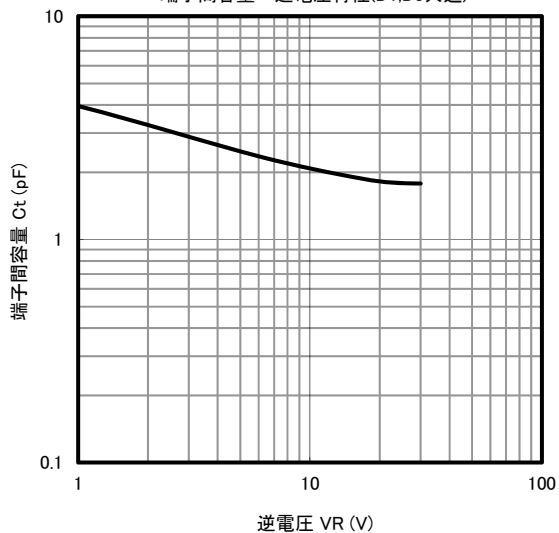
順電流－順電圧特性(D1,D3共通)



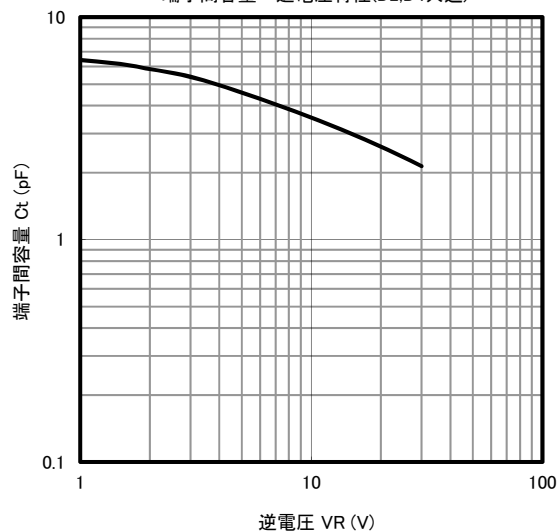
順電流－順電圧特性(D2,D4共通)



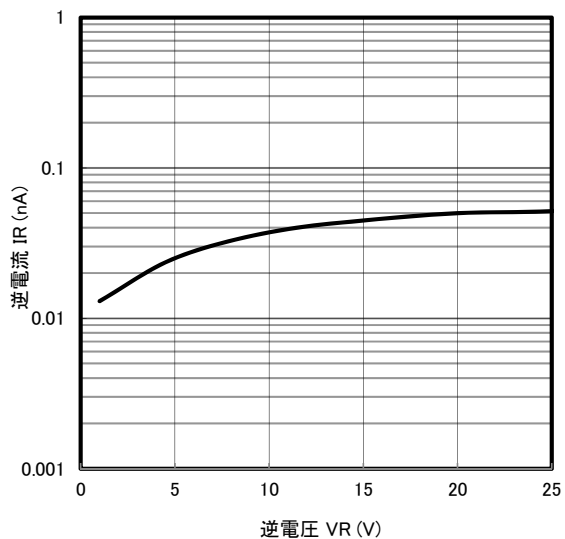
端子間容量－逆電圧特性(D1,D3共通)



端子間容量－逆電圧特性(D2,D4共通)



逆電流－逆電圧特性(D1,D2,D3,D4共通)



#### 安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生する場合や誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

#### 本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。